Источник питания ИП-3МГ для многомагнетронной СВЧ установки плазмохимического осаждения

Источник питания «ИП-3МГ», предназначен для преобразования переменного трехфазного напряжения промышленной сети в постоянный и генерации тока заданной формы, для питания магнетронов установки плазмохимического осаждения углеродных алмазоподобных пленок.

Технические характеристики источника плазмохимического осаждения

Технические параметры	Ед. изм. / Описание	Значение параметров
Напряжение питания	В	380+/-10%
Частота питающей сети	Гц	50+/-1
Количество выходных каналов	шт	3
Выходное напряжение	кВ	3.5-5
Длительность импульса регулируемая	мкс	100-5000
Длительность паузы регулируемая	мкс	100-5000
Частота импульсов	Гц	100-:-3500
Амплитуда тока в импульсе	А	0.03-2
Ток в паузе регулируется	А	0.03-2
Ток в непрерывном режиме	А	0.03-1
Ток накала (максимальный на канал)	А	11
Управление	С передней панели	
	По интерфейсу RS-485/232	
Точность стабилизации тока нормируется в диапазоне и составляет	А %	30мА-:-2А 0.5
Выходная мощность в импульсном режиме	кВт	30
Выходная мощность в непрерывном режиме	кВт	15
Охлаждение	Воздушное принудительное	
Размеры габаритные	мм	420x470x550

Вес	кг	45

Ток регулируется отдельно в каждом канале. Модуляция в каналах осуществляется по току, глубина модуляции регулируемая от 0 до 100%.
Управление и индикация осуществляется сенсорной панелью оператора.

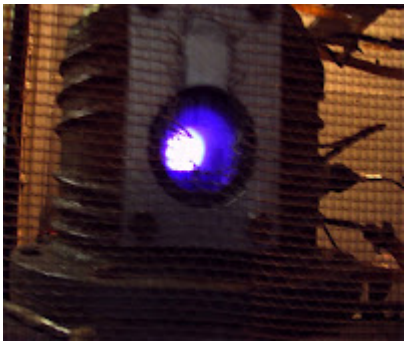
Фотографии источника питания ИП-3МГ



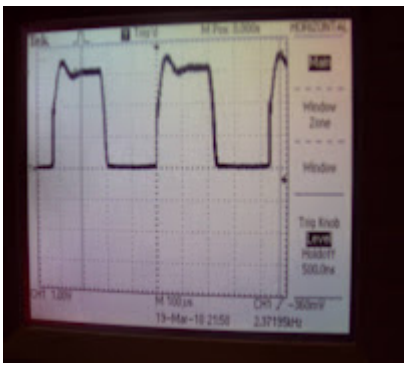
Общий вид



Сенсорная панель оператора



Плазма СВЧ поля



Осциллограмма импульсного СВЧ поля